

Silicon Diode

ITT3002

150V / 100mA

DATASHEET

OEM – ITT Intermetall

Source: ITT Intermetall Databook 73/74

ITT 3002

Silizium-Epitaxie-Planar-Diode
mit extrem niedrigem Sperrstrom bei hoher Sperrspannung

Glasgehäuse JEDEC DO-35
54 A 2 nach DIN 41 880
Gewicht ca. 0,13 g
Maße in mm

In listenmäßiger Ausführung wird diese Diode gegurtet geliefert. Näheres siehe unter „Gurtung“.



Grenzwerte

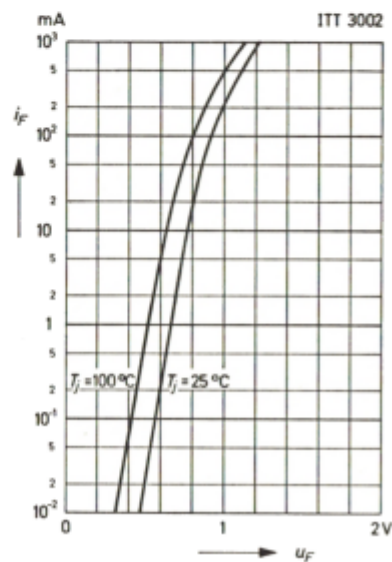
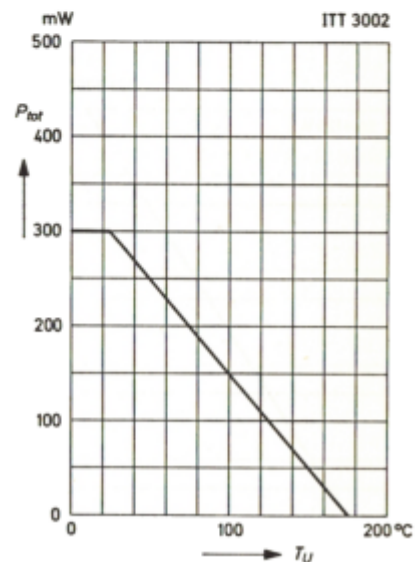
Spitzensperrspannung	U_{RM}	150	V
Richtstrom in Einwegschaltung mit R -Last bei $T_U = 25\text{ °C}$ u. $f \geq 50\text{ Hz}$	I_O	100 ¹⁾	mA
period. Spitzenstrom bei $f \geq 50\text{ Hz}$, $T_U = 25\text{ °C}$	I_{FRM}	200 ¹⁾	mA
Stoßstrom für $t < 1\text{ s}$ ausgehend von $T_j = 25\text{ °C}$, $C_j = 25\text{ °C}$	I_{FSM}	1	A
Verlustleistung bei $T_U = 25\text{ °C}$	P_{tot}	300 ¹⁾	mW
Sperrschichttemperatur	T_j	175	°C
Lagerungstemperaturbereich	T_S	-65...+200	°C

Kennwerte bei $T_j = 25\text{ °C}$

Durchlaßspannung bei $I_F = 200\text{ mA}$	U_F	<1	nA
Sperrstrom bei $U_R = 125\text{ V}$	I_R	<1	nA
bei $U_R = 125\text{ V}$, $T_j = 150\text{ °C}$	I_R	<3	μA
Durchbruchspannung gemessen mit 100- μA -Impulsen	$U_{(BR)R}$	>150	V

1) Dieser Wert gilt, wenn die Anschlußdrähte in 8 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.

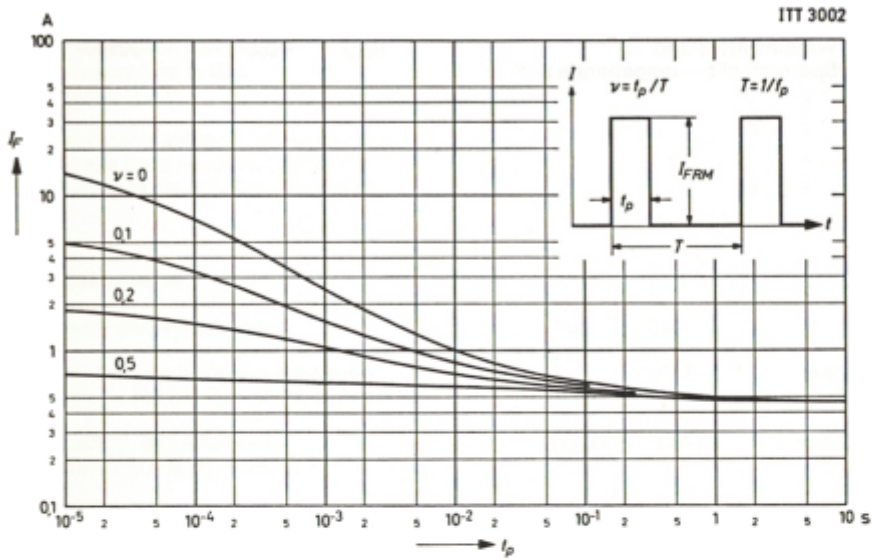
ITT 3002

Kapazität bei $U_F = U_R = 0$ C_{tot} <6 pFSperrverzug
beim Umschalten
von $I_F = 10$ mA auf $I_R = 10$ mA
bis $I_R = 1$ mA t_{rr} 250 nsWärmewiderstand
Sperrschicht - umgebende Luft R_{thU} <0,5¹⁾ K/mW**Durchlaßkennlinien**
 $T_J = 25$ °C; $T_J = 100$ °C**zulässige Verlustleistung
in Abhängigkeit von der
Umgebungstemperatur 1)**

1) Dieser Wert gilt, wenn die Anschlußdrähte in 8 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.

ITT 3002

**zulässige Belastung mit periodischen Impulsen
in Abhängigkeit von der Impulsdauer**
(siehe Fußnote auf Seite 137)



**Sperrstrom
in Abhängigkeit von der
Sperrschichttemperatur**

